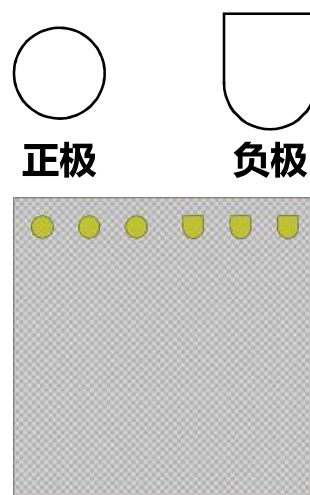


产品特点：

高功率密度
高光功率密度
易于光学适配的小发光面积
长寿命
大功率小电流应用

物理参数：

芯片尺寸	177mil X 177mil
	4.5mm X 4.5mm
芯片厚度	5.9mil
	150um
芯片发光尺寸	177mil X 177mil
	4.5mm X 4.5mm
电极尺寸	$\varphi = 3.94\text{mil}$
	$\varphi = 100\mu\text{m}$
正向电压	36V
电极材料	金 (Au)
电极数目	3 组

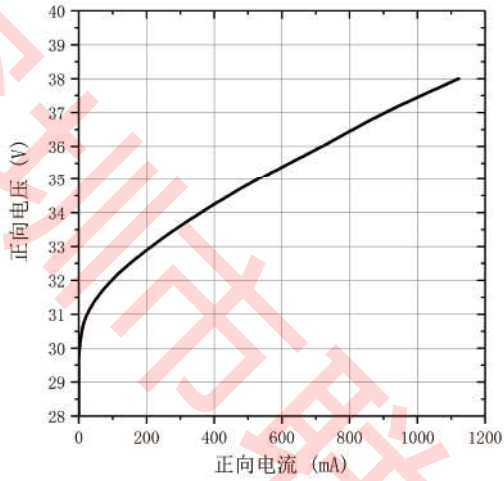


光电性能：

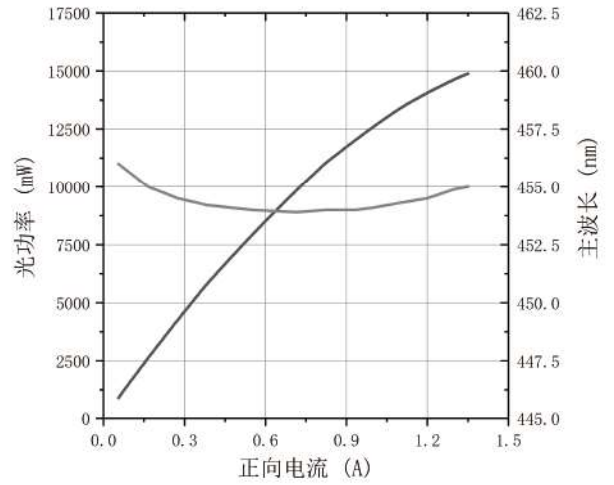
$T_j = 25^\circ\text{C}$

参数	测试条件	单位	最小值	典型值	最大值
正向电压(V_f)	@ $I_f=550\text{mA}$	V		36	40
正向电流(I_f)	/	A			1.4
反向电压(V_r)	@ $I_r=1\text{mA}$	V	300		
光功率(P)	@ $I_f=550\text{mA}$	mW		8000	
ESD	HBM JESD22-A114	V	8000		
主波长(λ_d)	@ $I_f=550\text{mA}$	nm	450	455	460
热阻($R_{\theta j}$)	P=20W	$^\circ\text{C}/\text{W}$		0.31	
芯片结温(T_j)	/	$^\circ\text{C}$			125
存储温度(T_s)	/	$^\circ\text{C}$	-40		85
封装温度(T_a)	/	$^\circ\text{C}$			260(<10s)

■ 特性曲线:

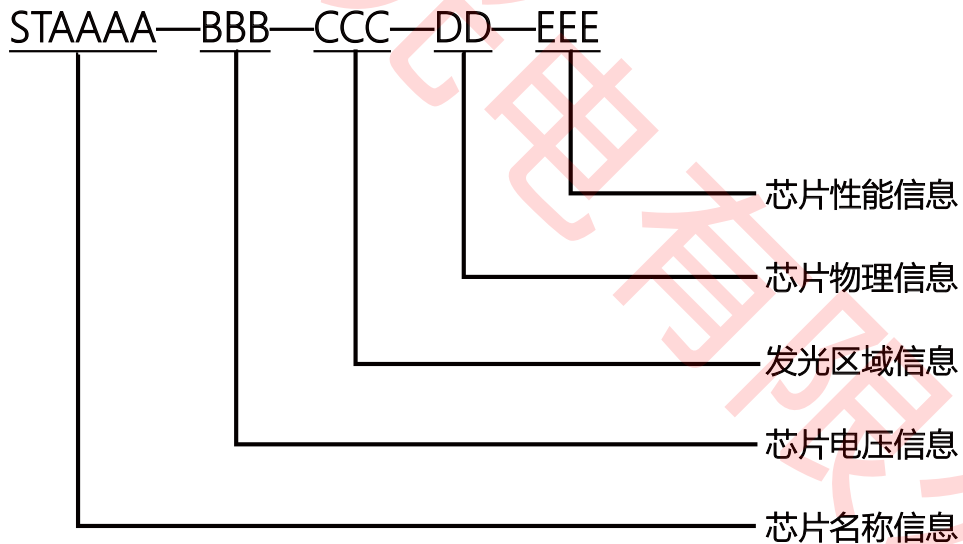


正向电流 Vs 正向电压



正向电流 Vs 光功率 & 主波长

■ 产品订购编号



- ST: 公司代号
- AAAA: 芯片尺寸
- BBB: 芯片电压等级
- CCC: 芯片发光图形及尺寸信息
- DD: 芯片光色及芯片类型
- EEE: 芯片性能分档